

**关键指标**

频率: DC~12GHz  
 插入损耗: 1.2dB/1.7dB  
 隔离度: 45dB  
 控制电平: 0/-5V  
 芯片尺寸: 1.98mm×1.67mm×0.1mm

**产品简介**

HG135K-1 是一款 DC~12GHz 非对称反射式单刀三掷开关芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 插入损耗为 1.2dB/1.7dB, 隔离度为 45dB。

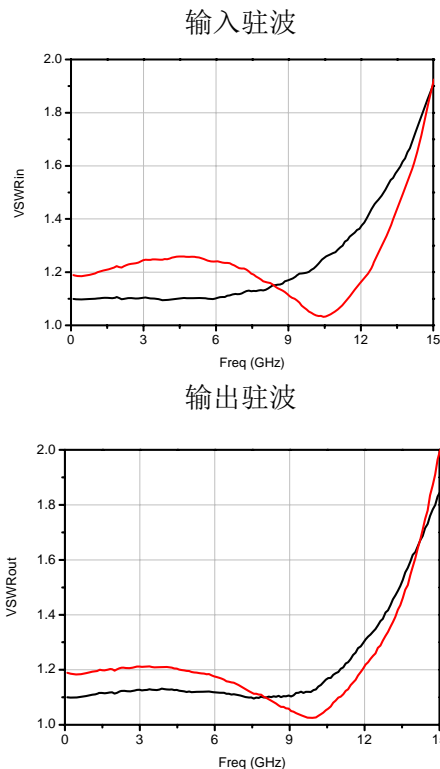
**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C)**

指标		最小值	典型值	最大值
频率(GHz)		DC~12		
输入驻波		-	1.3	-
输出驻波		-	1.3	-
插入损耗 (dB)	RF1	-	1.2	-
	RF2	-	1.7	-
隔离度(dB)		-	45	-

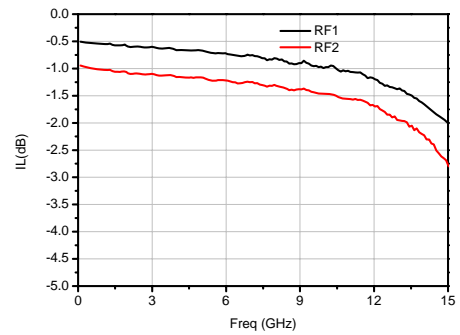
**真值表 (0: 0V, 1: -5V)**

C1	C2	C3	C4	RFC-RF1	RFC-RF2	RFC-Load
0	1	0	1	ON	OFF	OFF
0	1	1	0	ON	OFF	OFF
1	0	0	1	OFF	ON	OFF
1	0	1	0	OFF	OFF	ON

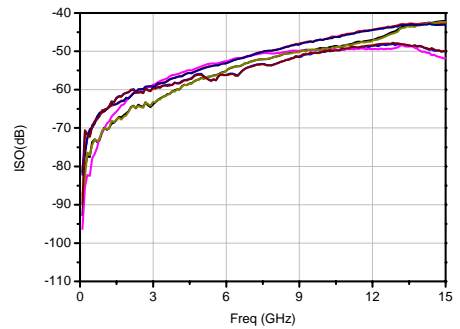
**典型测试曲线**



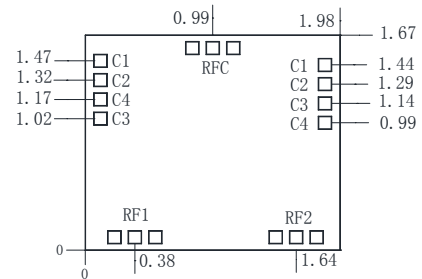
**插入损耗**



**隔离度**



**外形和端口尺寸 (mm)**



**绝对额定最大值**

最大输入功率	+27dBm	
控制电压	低电平: 0~-0.5V	高电平: -4~-5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

**注意事项**

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400μm;
5. 芯片微波端无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。